

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第6部門第2区分  
 【発行日】令和7年3月4日(2025.3.4)

【公開番号】特開2023-172703(P2023-172703A)  
 【公開日】令和5年12月6日(2023.12.6)  
 【年通号数】公開公報(特許)2023-229  
 【出願番号】特願2022-84683(P2022-84683)  
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/42(2006.01)

C 1 1 D 7/32(2006.01)

C 1 1 D 7/26(2006.01)

10

【F I】

G 0 3 F 7/42

C 1 1 D 7/32

C 1 1 D 7/26

【手続補正書】

【提出日】令和7年2月21日(2025.2.21)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

洗浄剤組成物を用いて、樹脂マスクが付着した被洗浄物から樹脂マスクを剥離する工程を含み、

前記洗浄剤組成物は、第四級アンモニウム水酸化物(成分A)、アミノアルコール(成分B)、芳香族アルコール(成分C)及び水(成分D)を含有する洗浄剤組成物であり、

30

前記洗浄剤組成物中の成分Dと成分Cとの質量比D/Cが10未満であり、

前記樹脂マスクが付着した被洗浄物は、細線部の線幅が5 $\mu$ m以上35 $\mu$ m以下、最厚部の厚さが40 $\mu$ m以上80 $\mu$ m以下の金属配線を有する基板の表面に硬化した樹脂マスクを有する基板である、洗浄方法。

【請求項2】

前記洗浄剤組成物中の成分Cの含有量が5質量%以上15質量%以下である、請求項1に記載の洗浄方法。

【請求項3】

前記洗浄剤組成物中の成分Dの含有量が45質量%以上80質量%以下である、請求項1又は2に記載の洗浄方法。

40

【請求項4】

前記洗浄剤組成物中の成分Aの含有量が2質量%以上5質量%以下である、請求項1又は2に記載の洗浄方法。

【請求項5】

前記洗浄剤組成物中の成分Bの含有量が9質量%以上15質量%以下である、請求項1又は2に記載の洗浄方法。

【請求項6】

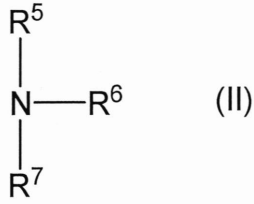
前記金属配線を有する基板は、表面に金属箔を有するガラスエポキシ多層基板である、請求項1又は2に記載の洗浄方法。

【請求項7】

50

成分 B が、下記式 ( I I ) で表される化合物である、請求項 1 又は 2 に記載の洗浄方法。

【化 1】



上記式 ( I I ) において、 $\text{R}^5$  は、水素原子、メチル基、エチル基又はアミノエチル基を示し、 $\text{R}^6$  は、水素原子、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、メチル基又はエチル基を示し、 $\text{R}^7$  は、ヒドロキシエチル基又はヒドロキシプロピル基を示す。

【請求項 8】

前記洗浄剤組成物中の成分 D と成分 C との質量比  $\text{D} / \text{C}$  が 5 以上 10 未満である、請求項 1 又は 2 に記載の洗浄方法。

【請求項 9】

請求項 1 又は 2 に記載の洗浄方法を用いて、樹脂マスクを有する電子回路基板を洗浄する工程を含む、電子部品の製造方法。

10

20

30

40

50